

Статьи из журнала «Успехи прикладной физики», переведенные и опубликованные в 2016 г. в англоязычных журналах

Уже более 20 лет одним из основных каналов представления на английском языке отечественных научных журналов зарубежному научному, техническому и деловому сообществу является известная программа Russian Library of Science, реализуемая совместно силами МАИК "Наука/Интерпериодика" (Россия), Pleiades Publishing (США) и Springer (Германия). В рамках этой программы синхронно с русскоязычными журналами (в основном, академическими) издаются и распространяются по всему миру их англоязычные варианты в виде отдельных журналов. Следует заметить, что юридически эти англоязычные журналы представляют собой уже самостоятельные издания относительно русскоязычных оригиналов. Так, они имеют отличные значения ISSN, а также различных издателей, распространителей и т.п. Более того, к статьям отечественного журнала в процессе подготовки его англоязычной публикации могут быть добавлены статьи из некоторых других отечественных журналов по отдельным официальным договорам (т.н. присоединенные журналы).

Журнал «Успехи прикладной физики» является участником указанной программы Russian Library of Science, В результате присутствия в указанной программе значительное число уже опубликованных статей журнала дополнительно срочно переводятся на английский язык и печатаются в текущих выпусках журналов **Plasma Physics Reports** (основной журнал – «Физика плазмы») и **Journal of Communications Technology and Electronics** (основной журнал – «Радиотехника и электроника»), естественно, с указанием всех исходных данных первоначальной публикации.

Ниже представлены списки статей из журнала «Успехи прикладной физики», уже переведенных и опубликованных в течение 2016 года в указанных англоязычных журналах. В каждой нумерованной позиции списка указываются библиографические данные статьи, опубликованной в соответствующем англоязычном журнале, а также все данные исходной русскоязычной публикации (в ячейке с фоновой заливкой).

1	<i>K. V. Artem'ev, A. M. Davydov, V. A. Ivanov, I. A. Kossyi, G. S. Luk'yanchikov, and I. V. Moryakov</i> Microwave Capillary Torch as a Means for Modifying the Electrophysical Characteristics of Metal Surfaces // Plasma Phys. Rep. 2016. Vol. 42. No. 7. P. 703.
	<i>Артемьев К. В., Давыдов А. М., Иванов В. А., Коссий И. А., Лукьянчиков Г. С., Моряков И. В.</i> Микроволновый капиллярный факел как средство воздействия на электрофизические характеристики металлической поверхности // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2. № 5. С. 486.
2	<i>I. D. Burlakov, A. I. Dirochka, M. D. Korneeva, V. P. Ponomarenko, and A. M. Filachev,</i> Solid State Photoelectronics: the Current State and New Prospects, p. 1166-1174 // J. Commun. Technol. Electron. 2016. Vol. 61. No. 10. P. 1166
	<i>Бурлаков И. Д., Дирочка А. И., Корнеева М. Д., Пономаренко В. П., Филачев А. М.</i> Твердотельная фотоэлектроника. Современное состояние и прогноз развития (обзор к 50-летию факультета физической и квантовой электроники Московского физико-технического института) // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2. № 5. С. 509.
3	<i>K. O. Boltar, I. D. Burlakov, V. P. Ponomarenko, A. M. Filachev, and V. V. Salo,</i> Solid-State Photoelectronics of the Ultraviolet Range (Review), // J. Commun. Technol. Electron. 2016. Vol. 61. No. 10. P. 1175
	<i>Болтарь К. О., Бурлаков И. Д., Пономаренко В. П., Филачев А. М., Сало В. В.</i> Твердотельная фотоэлектроника ультрафиолетового диапазона (обзор) // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2. № 6. С. 623.
	<i>S. V. Nebogatkin, I. E. Rebrov, V. Yu. Khomich, and V. A. Yamshchikov,</i> A Powerful Electrohydrodynamic Flow Generated by a High-Frequency Dielectric Barrier Discharge

4	in a Gas, // Plasma Phys. Rep. 2016. Vol. 42. No. 1. P. 104.
	<i>Небогаткин С. В., Ребров И. Е., Хомич В. Ю., Ямщиков В. А.</i> Мощный электрогидродинамический поток, создаваемый высокочастотным барьерным разрядом в газе // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2. № 6. С. 595.
5	<i>N. I. Iakovleva, A. V. Nikonov, and V. V. Shabarov,</i> Experimental Investigation and Calculation of the Spectral Dependence of the Absorption Coefficient of Single-Layer Epitaxial HgCdTe Structures, p. 1186-1193 // J. Commun. Technol. Electron. 2016. Vol. 61. No. 10. P. 1186
	<i>Яковлева Н. И., Никонов А. В., Шабаров В. В.</i> Экспериментальные исследования и расчеты спектральной зависимости коэффициента поглощения в однослойных эпитаксиальных структурах HgCdTe // Успехи прикладной физики. 2015. Т. 3. № 6. С. 579.
6	<i>V. D. Bochkov, B. N. Drazhnikov, P. A. Kuznetsov, K. V. Kozlov, and V. N. Solyakov,</i> Investigation of 1024 × 10 Multirow Focal Plane Arrays Based on the Solid Solution of Mercury–Cadmium–Telluride // J. Commun. Technol. Electron. 2016. Vol. 61. No. 10. P. 1194
	<i>Бочков В.Д., Дразжников Б.Н., Кузнецов П.А., Козлов К.В., Соляков В.Н.</i> Исследование многорядных ФПУ формата 1024×10 на основе КРТ // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2. № 1. С. 65.
7	<i>I. D. Burlakov, A. A. Drugova, and V. A. Kholodnov,</i> Principles of an Analytical Method of Optimization of Structure Parameters of Avalanche Heterophotodiodes with Separated Regions of Absorption and Multiplication // J. Commun. Technol. Electron. 2016. Vol. 61. No. 10. P. 1200
	<i>Бурлаков И.Д., Другова А.А., Холоднов В.А.</i> Принципы аналитического метода оптимизации параметров структуры лавинных гетерофотодиодов с разделенными областями поглощения и умножения // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2. № 4. С. 393.
8	<i>P. A. Kuznetsov and I. S. Moshchev,</i> Comparative Analysis of Readout Large-Scale Integrated Circuits with an Analog-to-Digital Converter in the Cell for a Photodetector of the Far Infrared Range // J. Commun. Technol. Electron. 2016. Vol. 61. No. 10. P. 1205
	<i>Кузнецов П.А., Мошчев И.С.</i> Сравнительный анализ БИС считывания с АЦП в ячейке для ФПУ длинноволнового ИК-диапазона // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2. № 1. С. 83.
9	<i>A. S. Sakharov, V. A. Ivanov, and M. E. Konyzhev,</i> Particle-in-Cell Simulation of Multipactor Discharge on a Dielectric in a Parallel-Plate Waveguide // Plasma Phys. Rep. 2016. Vol. 42. No. 6. P. 610.
	<i>Сахаров А. С., Иванов В. А., Коньжеев М. Е.</i> Численное моделирование методом частиц в ячейке мультипакторного разряда на диэлектрике в плоскопараллельном волноводе // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2. № 5. С. 476.
10	<i>V. A. Ivanov, A. S. Sakharov, and M. E. Konyzhev,</i> Formation of a Strong Electric Field Resulting in the Excitation of Microplasma Discharges at the Edge of a Dielectric Film on a Metal in a Plasma Flow // Plasma Phys. Rep. 2016. Vol. 42. No. 6. P. 619.
	<i>Иванов В.А., Сахаров А.С., Коньжеев М.Е.</i> Формирование сильного электрического поля, приводящего к возбуждению микроплазменных разрядов на краю диэлектрической пленки на металле в потоке плазмы // Успехи прикладной физики. 2013. Т. 1. № 6. С. 697.
	<i>N. I. Gusarova, N. F. Koshchavtsev, and S. V. Popov,</i>

11	Advantages of Solid-State Photodetectors for a Spectral Interval of 1.4–1.7 μm in Night-Vision Devices // J. Commun. Technol. Electron. 2016. Vol. 61. No. 10. P. 1214
	<i>Гусарова Н.И., Кошавцев Н.Ф., Попов С.В.</i> Преимущества использования твердотельных фотоприемных устройств на область спектра 1,4–1,7 мкм в приборах ночного видения // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2. № 3. С. 288.
12	<i>A. V. Filatov, V. V. Karpov, E. V. Susov, A. A. Gribanov, N. S. Kuznetsov, and V. I. Petrenko,</i> Photoresistors with the Gray Code on the $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ Heteroepitaxial Structures for a Spectral Interval of 2–11 μm with Thermoelectric Cooling // J. Commun. Technol. Electron. 2016. Vol. 61. No. 10. P. 1215
	<i>Филатов А. В., Карпов В. В., Сусов Е. В., Грибанов А. А., Кузнецов Н. С., Петренко В. И.</i> Фоторезисторы с кодом Грея из гетеро-эпитаксиальных структур $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ на спектральный диапазон 2—11 мкм с термоэлектрическим охлаждением // Успехи прикладной физики. 2015. Т. 3. № 2. С. 190.
13	<i>D. S. Andreev, K. O. Boltar, P. V. Vlasov, N. A. Irodov, and A. A. Lopuhin,</i> Investigation of Planar Photodiodes of a Focal Plane Array Based on a Heteroepitaxial InGaAs/InP Structure // J. Commun. Technol. Electron. 2016. Vol. 61. No. 10. P. 1220
	<i>Андреев Д.С., Болтарь К.О., Власов П.В., Иродов Н.А., Лопухин А.А.</i> Исследование планарных фотодиодов МФЧЭ на основе гетероэпитаксиальной структуры InGaAs/InP // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2. № 1. С. 60.

Журналы **Plasma Physics Reports** и **Journal of Communications Technology and Electronics** (но не их русскоязычные источники-оригиналы!!) анализируются и индексируются наиболее авторитетной международной наукометрической базой данных Web of Science (Thomson Reuters), где они имеют достаточно представительные импакт-факторы, а именно, 1,01 и 0,38 соответственно (за 2015 г.). Таким образом, значительное число статей из журнала «Успехи прикладной физики» также учитываются в указанной БД Web of Science.